

	<p>SIDR140DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDR140DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 25V PPAK SO-8DC</p>
	<p>Datenblätter:  SIDR140DP-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 2586 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


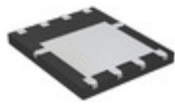

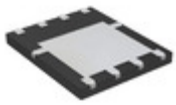
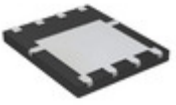


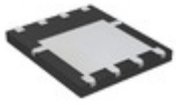
Spezifikationen

Teilenummer	SIDR140DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 25V PPAK SO-8DC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2586 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8DC
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.67 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIDR140DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8150pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 79A (Ta), 100A (Tc) 6.25W (Ta), 125W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	79A (Ta), 100A (Tc)

SIDR140DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDR140DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDR140DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIDR140DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC85D170HX1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 150A WAFER</p>	 <p>SIDR622DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 150V</p>	 <p>SIDC81D60E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 200A WAFER</p>	 <p>SIDR402DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V PPSO-8DC</p>
 <p>SIDR626DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V</p>	 <p>SIDEGIG-GUITAREVM N/A EVALUATION MODULE</p>	 <p>SIDC85D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 150A WAFER</p>	 <p>SIDR392DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>

SIDR140DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIDR140DP-T1-GE3 Datenblatt	SIDR140DP-T1-GE3-Datenblätter	SIDR140DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIDR140DP-T1-GE3
SIDR140DP-T1-GE3 Electronic	SIDR140DP-T1-GE3 Komponenten	SIDR140DP-T1-GE3 Hersteller	SIDR140DP-T1-GE3 Verteiler	SIDR140DP-T1-GE3 Bild	SIDR140DP-T1-GE3 Teil
SIDR140DP-T1-GE3 Preis	SIDR140DP-T1-GE3 Original	SIDR140DP-T1-GE3 Bild	SIDR140DP-T1-GE3 garantiert	SIDR140DP-T1-GE3 Aktie	SIDR140DP-T1-GE3 Inventar
SIDR140DP-T1-GE3 Neu		SIDR140DP-T1-GE3 Original	SIDR140DP-T1-GE3 garantiert	SIDR140DP-T1-GE3 RFQ	SIDR140DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited